# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-305917

(43)Date of publication of application: 28.10.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/027

(21)Application number : 03-094863

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

02.04.1991

(72)Inventor: OZEKI HISAO

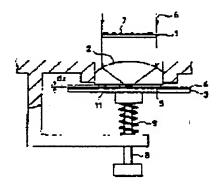
MATSUBARA TAKASHI

## (54) ADHESION TYPE EXPOSURE DEVICE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To thin film thickness of an immersion liquid and reduce the quantity of light absorbed, and to minimize and prevent exposure unevenness in an adhesion type exposure device.

CONSTITUTION: The adhesive surface 11 of an exposure lens is hydrophilic—treated by a hydrophilic solution such as alcohol. A wafer 3 coated with a photoresist 4 is fast stuck on the hydrophilic—treated adhesive surface 11 through an immersion liquid 5, and the pattern 7 of a photomask 1 is transferred onto the wafer 3 by the irradiation of irradiation light 6. Wafer absorbing properties are improved in the hydrophilic—treated adhesive surface 11, and the film thickness of the immersion liquid 5 is made thin.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

**BEST AVAILABLE COPY** 

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公司委号

## 特開平4-305917

(43)公問日 平成4年(1992)10月28日

(51) Int.CL. <sup>3</sup> H 0 1 L 21/027	熱別配号	庁內蓋亞鲁号	F J	技術表示管所
		7013-4M	H01L 21/30	341 S
		7352-4M		311 A

## 容質請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

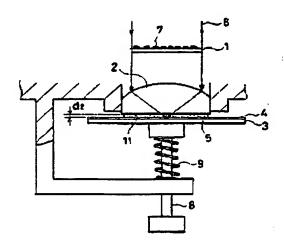
(21) 出題番号	<b>特膜平3-94863</b>	(71)出題人	000004112
			株式会社ニコン
(22) 出頭 日	平成3年(1991)4月2日		東京電子代田区丸の内3丁目2番3号
		(72) 数据者	大阪尚夫
		(1-0-7C-32-m	東京都島川区西大井一丁目6番3号 株式
			会社ニコン大井製作所内
		(72) 発明者	松原 隆
			東京都品川区西大井一丁目6番3号 掠式
			会社ニコン大井蛭作所内
		(74) (493)	分理土 山川 政樹
		(10) GEX	THE WIN KIN
			·
		1	
		1	
		I	

## (54) 【発明の名称】 密着型質光技管

## (57) 【要約】

【目的】 宿着型羅光装置において、長液の膜厚を薄く して光の吸収量を少なくし、露光ムラを軽減助止するこ とを目的とする。

【特成】 観光レンズの密急面11をアルコール等の親 水溶液によって親水化処理する。この親水化処理された 密着面11にフォトレジスト4を垫布されたウエハ3を **経抜** 5 を介して告寄させ、照射光 6 の原射によりフォト マスク1のパターンでをウェハ3上に転写する。 観水化 処理された密着面11は、嵌水性が向上し、裂波5の膜 厚を薄くする。



#### 【特許請求の範囲】

【開菜項1】 投影光学系もしくはフォトマスクのウエ 八杏者面を親水化処理し、この親水化処理された杏着目 にフォトレジストを適存されたウエハを接後を介して密 着させ、照射光の照射によりフォトマスクのパターンを 前記フォトレジストに転写するようにしたことを特徴と する密着型露光装団。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、LSIの製造工程にお 10 いて、フォトマスク上のパターンモウエハ上に役影館光 する露光波包、特に密管型露光技管に関するものであ

#### (0002)

【従来の技術】 レーザー光等を照射しフォトマスク上の パターンを投影光学系によってシリコンウエハ等の学導 体拡松上に投影総光するこの種の露光袋置における総光 方式としては、①密着(コンタクト)電光方式、②プロ キシミティ観光方式、③反射型投影観光方式、⑤縮小レ ンズ投影解光方式の4方式が知られている。

【0003】このうち密菊鶴光方式は、フォトマスク (または投影光学系) とウエハとを密着させて開光する もので、これらが完全に依若している場合には、フォト レジスト中の波長が風折率分の1に短くなるため、固折 の影響が少なく、高解像皮の転写が得られるという特色 を有している。しかし、完全な密碧を実現することは観 めて難しく、またフォトマスクとウエハとを機械的に辞 **勉させているためにウエハ衰菌の突起等によりフォトマ** スクに欠陥が生じ、その寿命を低下させると同時にデバ イスの歩星りに影響を及ぼすといった問題があった。

【0004】そこで、複岩銀光方式によるこのような問 **超を解決する方法としてフォトマスクとウエハ間に被体** (役骸)を充填している。 図2は投影光学系にウエハを 告着させた場合を示すもので、1はフォトマスク、2は 投影光学系の一部を構成する鍵光レンズ、3はフォトレ ジスト4が整布されたウエハ、5は億光レンズ2とウエ ハ3間に充鎖された侵族、6はフォトマスク1のパター ン?を照射しフォトレジスト4を解光する照射光、8は ウエハ3を保持する保持体、9は保持体8を上方に付勢 である。照射光6の波長は短いほど回折の影響が少な く、そのため光源としてエキシマレーザー等のレーザー 就像が用いられる。 役被 5 としては、 頭折率がフォトレ ジスト4と同程度で光の吸収が少なく、しかもフォトレ ジスト4を溶かさないものが望ましく。通常拡水が使用 される.

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上述し たような投放5を使用した密着型能光线管においては、 没依5 自身の腹原ムラがあると、浸液5 による照射光6 50 電光装置によれば、投影光学系をたはフォトマスクのウ

の吸収量にムラが生じるため、コンタクト電光されたフ オトレジスト4のパターンが的確に露光されている部分 とそうでない部分とが生じてしまうという問題があっ た。したがって、このような観光ムラの発生を防止する ため、役被5の鎮厚は1を奪くし、光の吸収ムラを少な くすることが望まれている。

【0006】本発明は上途したような従来の問題点およ び夏登に鑑みてなされたもので、その目的とするところ は、浸液の膜壁を軽くし、露光ムラを軽減防止し得るよ うにした密若型露光袋匠を提供することにある。

#### [0007]

【課題を祭決するための手段】本発明は上記目的を達成 するため、投影光学系もしくはフォトマスクのウエハ密 若面も起水化処理し、この超水化処理された密着面にフ ォトレジストを強布されたウエハを浸液を介して密管さ せ、照射光の照射によりフォトマスクのパターンを前配 フォトレジストに転写するようにしたものである。

#### [8000]

[作用] 本発明において、報水化処理された投影光学系 もしくばフォトマスクのウエハ告着面は、吸水性が向上 し、受液の膜原を誇くする。

#### [0009]

【実施例】以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて 詳細に説明する。 図1は本発明に係る密着型露光装置の 一典鮑何を示す要部の断面図である。なお、図中図2と 両一構成部品のものに対しては両一特号を以て示し、そ の説明を省略する。本実施師は投影光学系にウエハを密 特させた場合を示すもので、フォトマスク投影光学系の 一部を構成する露光シンズ2のウエハ密岩面11を予め が 親水化処理し、この親水化処理された倍増面11にウエ ハ3を施水等の侵続5を介して寄着させ、照射光6の展 新によりフォトマスク1のパターン7をウエハ3上に転 写するようにしたものである。

【0010】 較水化処理は、アルコール系等の頼水溶液 で密着面11を奇疑に拭き、レンズ表面の汚れを取るこ とで行なわれる。そして、この親水化処理後密着面11 にウエハ3を投掖5を介して答着させ、ウエハ3を露光 レンズ2にばね9により所定圧にて押しつける。

【0011】かくしてこのような構成においては、「秋水 しウエハ3を露光レンズ2に押し付ける圧縮コイルばね 40 化処理によって密着面11の吸水性を向上させているの 吸水効果が大きく、したがって、 寝蔽5の表面張力が小 さくなって満れ性が上がるため、役款5の数厚は2 を図 2 に示した従来装置と比較して蹲くする (d2 <d1) ことができ、また膜原が薄くなれば光の吸収量も少なく なるので、これに比例して光の吸収ムラが減少し、軽光 ムラを経済防止することができる。

## [0012]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る密管部

--98-

(3)

特別平4-305917

エハ密菊面を微水化処理し、この微水化処理された密容 図に、フォトレジストを独布されたウエハを段波を介し て密容させるように構成したので、段波自身の表面張力 を減らして連れ性を向上させることができる。したがっ て、役故の旗厚を輝くするができ、また膜厚が薄くなれ ば没被の旗厚ムラも少なくなるため、光の役収が少な く、役被による露光ムラを軽減防止することができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る密着型離光装置の一実施例を示す 要部の断面図である。

【図2】 密着型爬光装配の従来例を示す妥邸の新面図で

【符号の説明】

- 1 フォトマスク
- 2 露光レンズ
- 3 ウェ
- 4 フォトレジスト
- 5 授液
- 6 照射光
- 7 マスク
- 10 11 密带面

